



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H6718V

对应国外型号
2N6718

主要用途

音频放大、开关功率放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150
T_j ——结温	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	1.6W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	100V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	100V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	5V
I_C ——集电极电流	1A

外形图及引脚排列

TO-126ML



- 1—发射极, E
2—集电极, C
3—基极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{CB}}=80\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$
h_{FE1}	直流电流增益	80				$V_{\text{CE}}=1\text{V}$, $I_{\text{C}}=50\text{mA}$
h_{FE2}		50		250		$V_{\text{CE}}=1\text{V}$, $I_{\text{C}}=250\text{mA}$
h_{FE3}		20				$V_{\text{CE}}=1\text{V}$, $I_{\text{C}}=500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和压降			350	mV	$I_{\text{C}}=350\text{mA}$, $I_{\text{B}}=35\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	100			V	$I_{\text{C}}=100\mu\text{A}$, $I_{\text{E}}=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	100			V	$I_{\text{C}}=1\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0$
BV_{EBO}	集电极—基极击穿电压	5			V	$I_{\text{E}}=10\mu\text{A}$, $I_{\text{C}}=0$
f_{T}	特征频率	50			MHz	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$, $I_{\text{C}}=50\text{mA}$,
C_{ob}	输出电容		20		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$, $I_{\text{E}}=0$